SOLID-STATE IMAGE SENSING DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

Patent number:

JP6125070

凤 US5371397 (A1)

Also published as:

Publication date:

1994-05-06

Inventor:

MAEKAWA SHIGETO; others: 02

Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Classification:

- International:

H01L27/14; G02B27/00; H04N5/335

- european:

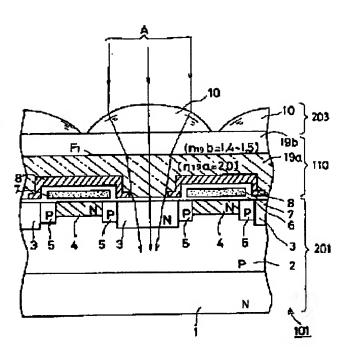
Application number:

JP19920298135 19921009

Priority number(s):

Abstract of JP6125070

PURPOSE:To prevent incident light from dispersing to the periphery of a light- receptive section and control smearing without degrading the sensitivity of the light-receptive section. CONSTITUTION:A luminous dispersion layer 19 is formed between an element 201 and lens layer 203. The luminous dispersion layer 19 consists of a light transmission layer 19b of a higher refractive index on the incidence side; and a light transmission layer 19a of a lower refractive index on the exit side. The luminous dispersion layer 19 refracts and disperses incident light A, collected by the lens layer 203, so that the light will be as close to a parallel luminous flux as possible.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-125070

(43)公開日 平成6年(1994)5月6日

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機 株式会社エル・エス・アイ研究所内

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機 株式会社エル・エス・アイ研究所内

	識別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
27/14						
27/00	J	9120-2K				
5/335	V					
		7210-4M	H01L	27/ 14		D
			a	备查請求	未請求	請求項の数11(全 25 頁)
	特顯平4-298135		(71)出願人	000006013		
	平成 4 年(1992)10月 9 日					丸の内二丁目2番3号
			(72)発明者			
				兵庫県伊	P丹市瑞 [原4丁目1番地 三菱電機
				株式会社	上エル・コ	ェス・アイ研究所内
			(72)発明者	山本 秀	手和	
	27/00 5/335	27/14 27/00 J 5/335 V 特願平4-298135	27/14 27/00 J 9120-2K 5/335 V 7210-4M 特顯平4-298135	27/14 27/00 J 9120-2K 5/335 V 7210-4M H 0 1 L 特顯平4-298135 (71)出願人 平成 4 年(1992)10月 9 日	27/14 27/00	27/14 27/00 J 9120-2K 5/335 V 7210-4M H 0 1 L 27/14 審査請求 未請求 特願平4-298135 (71)出願人 000006013 三菱電機株式会社 東京都千代田区記 (72)発明者 前川 繁登 兵庫県伊丹市瑞川 株式会社エル・コ

(72)発明者 川島 光

(74)代理人 弁理士 早瀬 憲一

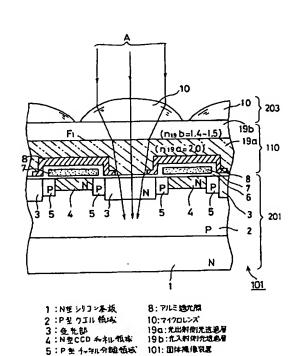
5:P型 イーヤル分離領域 6:ゲール 総飲膜 7:ゲート電 福

(54) 【発明の名称 】 固体撮像装置とその製造方法

(57)【要約】

[目的] 受光部の感度を低下させることなく、入射光の受光部周辺への広がりを抑えてスミアの低減を図る。

【構成】 素子部201とレンズ層203との間に、屈折率の高い光入射側光透過層19bと屈折率の小さい光出射側光透過層19aとからなり、上記レンズ層203により集光された入射光Aをこれが平行光束により近い光束となるよう上記両光透過層の接触界面での屈折により分散する光束分散層19を配設した。



110: 元泉分叛暦 201:素子部 203: レンス居

【特許請求の範囲】

【請求項1】 入射光を受け光電荷を発生する複数の受光部、及び各受光部で発生した光電荷を転送する転送部を半導体基板上に作り込んでなる素子部と、上記素子部上に設けられ、入射光の上記受光部への集光が各受光部に対応する領域毎に行われるよう構成したレンズ層とを備えた固体撮像装置において、

上記レンズ層と素子部との間に配置され、屈折率の異なる光透過層を有し、上記レンズ層により集光された集光 光束をこれが平行光束により近い光束となるよう上記光 透過層により分散する光束分散層を備えたことを特徴と する固体撮像装置。

【請求項2】 請求項1記載の固体撮像装置において、 上記光束分散層は、屈折率の高い光入射側の光透過層 と、屈折率の小さい光出射側の光透過層とから構成され ていることを特徴とする固体撮像装置。

【請求項3】 請求項2記載の固体撮像装置において、 上記光入射側光透過層と光出射側光透過層とが形成する 接触界面は、その受光部上に位置する部分が凹状に湾曲 した凹レンズ形状となっていることを特徴とする固体撮 像装置。

【請求項4】 請求項1記載の固体撮像装置において、 上記光束分散層は、屈折率の小さい光入射側光透過層 と、屈折率の小さい光出射側光透過層と、該両光透過層 間にこれらの層と接触して介在する屈折率の大きい中間 光透過層とを有し、

上記光入射側光透過層と中間光透過層との接触界面は全面に渡ってフラットな形状となっており、上記中間光透過層と光出射側光透過層との接触界面はその受光部上の部分が凸状に湾曲した凸レンズ形状となっていることを特徴とする固体提像装置。

【請求項5】 請求項1記載の固体撮像装置において、上記光束分散層は、屈折率の大きい光入射側光透過層と、屈折率の小さい光出射側光透過層とからなり、上記両光透過層の接触界面は、その受光部上の部分が凸状に湾曲した凸レンズ形状となっていることを特徴とする固体撮像装置。

【請求項6】 請求項1記載の固体撮像装置において、 上記光束分散層として、上記受光部の配列パターンに対 応させて複数の凹レンズ部を配列してなる凹レンズアレ イ膜を上記素子部上に貼り付け、

上記レンズ層として、上記受光部の配列パターンに対応 させて複数の凸レンズ部を配列してなる凸レンズアレイ 膜を上記凹レンズアレイ膜上に貼り付けたことを特徴と する固体撮像装置。

【請求項7】 複数の受光部、及び各受光部で発生した 光電荷を転送する転送部を作り込んだ半導体基板上全面 に第1の透明絶縁膜を堆積する第1の工程と、

該第1の透明絶縁膜を異方性エッチングして、上記半導体基板上の、受光部の周縁部分にサイドウォールを形成

する第2の工程と、

上記半導体基板全面に、上記第1の透明絶縁膜と同一の 屈折率を持つ第2の透明絶縁膜を下地表面の凸凹形状が その表面形状に反映されるよう形成する第3の工程と、 上記第2の透明絶縁膜上に、該絶縁膜より屈折率の小さ い第3の透明絶縁膜をその表面が平坦となるよう形成す る第4の工程と、

上記第3の透明絶緑膜上の、上記複数の受光部に対応する各領域にそれぞれ、この絶緑膜と屈折率が同一の材料からなる凸レンズを形成する第5の工程とを含むことを特徴とする固体撮像装置の製造方法。

【請求項8】 複数の受光部、及び各受光部で発生した 光電荷を転送する転送部を作り込んだ半導体基板上全面 に第1の透明絶緑膜をその表面が平坦になるよう堆積す る第1の工程と、

上記第1の透明絶縁膜上に、上記受光部に対応する部位 に開口を有する耐エッチング性膜を形成する第2の工程 と、

上記耐エッチング性膜をマスクとして第1の透明絶縁膜 に等方性エッチングを施して、該透明絶縁膜の、各受光 部上の部分に凹状湾曲面を形成する第3の工程と、

上記耐エッチング性膜を除去した後、上記第1の透明絶 緑膜上に、該絶縁膜より屈折率が小さい第2の透明絶縁 膜をその表面が平坦となるよう堆積する第4の工程と、 上記第2の透明絶縁膜上の、上記複数の受光部に対応す る各領域にそれぞれ、この絶縁膜と屈折率が同一の材料 からなる凸レンズを形成する第5の工程とを含むことを 特徴とする固体撮像装置の製造方法。

【請求項9】 複数の受光部、及び各受光部で発生した 光電荷を転送する転送部を作り込んだ半導体基板上全面 に第1の熱可塑性透明樹脂膜を、下地表面の凸凹形状が その表面形状に反映されるよう堆積する第1の工程と、 上記第1の熱可塑性透明樹脂膜をリフローしてその受光 部上の部分に凹状湾曲面を形成する第2の工程と、

上記第1の熱可塑性透明樹脂膜上に該樹脂膜より屈折率 の小さい第2の透明樹脂膜をその表面が平坦になるよう 形成する第3の工程と、

上記第2の透明樹脂膜上の、上記複数の受光部に対応する各領域にそれぞれ、この樹脂膜と屈折率が同一の材料からなる凸レンズを形成する第4の工程とを含むことを特徴とする固体撮像装置の製造方法。

【請求項10】 複数の受光部、及び各受光部で発生した光電荷を転送する転送部を作り込んだ半導体基板上全面に第1の透明絶縁膜をその表面が平坦になるよう堆積する第1の工程と、

上記第1の透明絶縁膜上に、屈折率がこれと同一の熱可塑性透明樹脂を形成し、該熱可塑性透明樹脂のパターニング及び熱リフローを行って、上記第1の透明絶縁膜上の、上記複数の受光部に対応する各領域にそれぞれ凸レンズを形成する第2の工程と、

その後全面に上記熱可塑性樹脂より屈折率が大きい透明な材料を上記熱フロー温度よりも低温で、その表面が平坦になるよう堆積して第2の透明絶縁膜を形成する第3の工程と、

上記第2の透明絶縁膜上にこの絶縁膜より屈折率の小さい第3の透明絶縁膜を形成し、その後第3の透明絶縁膜上の、上記複数の受光部に対応する各領域にそれぞれ、この絶縁膜と屈折率が同一の材料からなる凸レンズを形成する第4の工程とを含むことを特徴とする固体撮像装置の製造方法。

【請求項11】 請求項10記載の固体撮像装置の製造 方法において、

上記第3及び第4の工程に代えて、

上記熱可塑性透明樹脂より屈折率が大きい光透過膜を、 熱フロー温度よりも低温で下地表面の凹凸形状がその表 面形状に反映されるよう、堆積する第5の工程を含むこ とを特徴とする固体撮像装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は固体撮像装置及びその 製造方法に関し、特に受光部に入射する集光光束を分散 することによりスミアの低減を図るための光束分散層の 構造及びその形成方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図13及び図14は例えばIEDM1983でIshihara等が発表した従来の固体撮像装置を説明するための図であり、図13(a) はその半導体基板上での拡散領域の配置を示す平面図、図13(b) は転送電極及び遮光膜の配置を示す平面図であり、図14(a) 及び図14(b) はそのXIVa一XIVa線断面及びXIVb—XIVb線断面の構造を示す断面図である。なお、図13では半導体基板上の平坦化膜及びレンズ層は省略している。

【0003】図において、200は固体撮像装置であり、二次元アレイ状に配列された平面略正方形形状の受光部と、各受光部列の間に配置され、各受光部で発生した光電荷を垂直方向に転送する垂直CCD(電荷転送素子)と、上記各受光部と垂直CCDとの間に設けられたトランスファーゲート部とを有する素子部201、該素子部201上に配置され、入射光の上記受光部への集光が各受光部に対応する領域毎に行われるよう形成したレンズ層203、及び上記素子部201とレンズ層203との間に介在し、レンズ層203で集光された集光光束の光路長を調整する光路長調整層202から構成されている。

【0004】すなわち上記素子部201では、上記N型シリコン基板1上にP型ウェル領域2が形成され、該P型ウェル領域2の表面部分には、上記受光部としての第1N型半導体層3、上記垂直CCDのチャネル領域としての第2N型半導体層(以下N型CCDチャネル領域と

いう。)4及び上記トランスファーゲート部のチャネル領域としての低濃度N型半導体領域(以下N-型TGチャネル領域という。)4aが形成されており、上記受光部である第1N型半導体層3の周囲には、P型半導体層5からなるチャネル分離領域が形成されている。

【0005】また上記CCDチャネル領域4上にはシリコン酸化膜6からなるゲート絶縁膜を介して、第1ポリシリコン膜7aよりなるCCDゲート電極及び第2ポリシリコン膜7bよりなるCCDゲート電極が垂直CCDの転送方向に沿って交互に配置されている。ここで上記第1ポリシリコン膜7aの、上記N-型TGチャネル領域4a上の部分はトランスファーゲート電極となっている。

【0006】さらにCCDゲート電極及びトランスファーゲート電極、つまり上記第1及び第2ポリシリコン膜7a,7bの、N型CCDチャネル領域4上及びN-型TGチャネル領域4a上の部分の上方にはこれに覆い被さるようアルミ膜8が形成されており、該アルミ膜8は上記各チャネル領域4,4aへ入射する光を遮る遮光膜(以下アルミ遮光膜という。)となっている。

【0007】また光路長調整層202は、上記アルミ遮光膜8上全面に形成され、透明樹脂からなる平坦化膜9であり、上記レンズ層203は、この平坦化膜9上の、上記複数の受光部3に対応する各領域に配設され、入射光Aを各受光部に集める凸形マイクロレンズ10から構成されている。またここでは上記マイクロレンズ10は、図13(a)の二点鎖線Bで示すように受光部を中心としてCCDチャネル領域4側に張り出した平面楕円形状となっており、つまり受光部3の周辺領域、つまりN型CCDチャネル領域4,N型TGチャネル領域4a及びP型チャネル分離領域5上に降り注ぐ入射光も上記受光部3に導入できるようになっている。

[0008]次に動作について説明する。上記固体撮像 装置200の受光面に入射した光Aは、上記マイクロレンズ10によって受光部3に集光される。この際上記レンズ10によって、各受光部周辺のアルミ遮光膜8上に入射した光も受光部3に集められる。これにより各受光部3はその面積が小さくても実質的には大きな感度を持つこととなる。

【0009】そして上記集光した光によって受光部3で発生した光電子は受光部3に蓄積され、所定のタイミングでもってTRチャネル領域4aを通してCCDチャネル領域4へ移され、CCDの転送動作により後段の信号処理装置に出力される。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】ところが、従来の固体 撮像装置200では、入射光による光電子は上記P型ウェル領域2の、CCDチャネル領域4に近い領域でも発 生し、これがCCDチャネル領域4に入り込んで転送中 の信号電荷と混ざり、スミアとよばれるノイズになると いう問題があった。

【0011】すなわち、上記レンズ10の焦点 f 10は通常、上記受光部を構成する第1N型半導体層3の内部に位置するよう設定されており、その焦点位置より下側では入射光Aは逆に広がってしまうため、ウェル領域2の深い部分では、上記受光部3の直下部分を中心とする広範な領域で光電子E0,E1が発生する。例えば、入射光Aの一部が図14に示すように、チャネル分離層5の直下部分にまで到達し、上記入射光による光電子の一部EIがCCDチャネル領域4に入り込むこととなる。

【0012】なお、このように素子部上に透明絶縁層を介してレンズ層を形成してなる固体撮像装置は、特開昭61-64158号公報、特開平2-280376号公報、特開昭60-145776号公報、特開昭2-65171号公報等にも示されており、特に特開昭61-64158号公報、特開平2-280376号公報、特開昭2-65171号公報記載の固体撮像装置は、上記従来の固体撮像装置200と同様、受光部や電荷転送部を形成した半導体基板上に透明膜を介して集光レンズを形成してなるもので、これらの装置では、基板の受光部下側部分での入射光の広がりにより、スミアが発生するという上記と同様な問題がある。

【0013】また上記特開昭60-145776号公報記載の固体撮像装置は、受光部上の部分が凹状に湾曲したパッシベーション膜や層間絶縁膜のレンズ作用により入射光が散乱されるのを防止するため、上記凹状湾曲部上に集光レンズを配置したものであるが、この場合も、集光レンズにより集光された入射光が基板の受光部下側部分で広がることとなり、上記と同様スミアの発生を招くこととなる。

【0014】また上記特開平2-103962号公報記載の固体撮像装置は、集光レンズ部での集光能力を高めるため、集光レンズ部を、屈折率の大きい材料からなる凸レンズと、その下側に配置され、屈折率の小さい材料からなる凹レンズとから構成し、各レンズでそれぞれ集光を行うようにしたものであるが、この場合基板の受光部下側部分での入射光の広がりは一層大きくなり、上記のようなスミアの発生が助長されてしまう。

【0015】この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、受光部の感度を低下させることなく、光電子のCCDチャネル領域への漏れ込みによるスミアを低減できる固体撮像装置及びその製造方法を得ることを目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】この発明に係る固体撮像装置は、複数の受光部、及び転送部を有する素子部と、入射光の上記受光部への集光が各受光部に対応する領域毎に行われるよう構成したレンズ層との間に、屈折率の異なる2つの光透過層を有し、上記レンズ層により集光された集光光束をこれが平行光束により近い光束となる

よう上記光透過層での屈折により分散させる光束分散層 を配設したものである。

【0017】この発明は上記固体撮像装置において、上記光東分散層を、屈折率の高い光入射側光透過層と、屈折率の小さい光出射側光透過層とから構成したものである。

[0018] この発明は上記固体撮像装置において、上記光入射側光透過層と光出射側光透過層との接触界面の、各受光部上に位置する部分を凹状に湾曲した凹レンズ形状としたものである。

【0019】この発明は上記固体撮像装置において、上記光束分散層の構造を、上記屈折率の小さい光入射側光透過層と、屈折率の小さい光出射側光透過層と、該両光透過層間にこれらの層と接触して介在する屈折率の大きい中間光透過層とを有し、上記光入射側光透過層と中間光透過層との接触界面が全面に渡ってフラットな形状となっており、上記中間光透過層と光出射側光透過層との接触界面の、各受光部上の部分が凸状に湾曲した凸レンズ形状となっている構造としたものである。

[0020] この発明は上記固体撮像装置において、上記光束分散層の構造を、屈折率の大きい光入射側光透過層と、屈折率の小さい光出射側光透過層とからなり、上記両光透過層の接触界面の、上記受光部上の部分が凸状に湾曲した凸レンズ形状となった構造としたものである。

[0021] この発明は上記固体撮像装置において、上記光東分散層として、上記受光部の配列パターンに対応させて複数の凹レンズ部を配列してなる凹レンズアレイ膜を上記素子部上に貼り付け、上記レンズ層として、上記受光部の配列パターンに対応させて複数の凸レンズ部を配列してなる凸レンズアレイ膜を上記凹レンズアレイ膜上に貼り付けたものである。

【0022】この発明に係る固体撮像装置の製造方法は、複数の受光部及び電荷転送部を作り込んだ半導体基板上全面に第1の透明絶縁膜を堆積した後、該第1の透明絶縁膜を異方性エッチングして、上記半導体基板上の、受光部の周縁部分にサイドウォールを形成し、次に上記半導体基板全面に、上記第1の透明絶縁膜と同一の屈折率を持つ第2の透明絶縁膜を下地表面の凸凹形状がその表面形状に反映されるよう形成し、上記第2の透明絶縁膜上に、該絶縁膜より屈折率の小さい第3の透明絶縁膜をその表面が平坦となるよう形成し、上記第3の透明絶縁膜をその表面が平坦となるよう形成し、上記第3の透明絶縁膜上の、上記複数の受光部に対応する各領域にそれぞれ、この絶縁膜と屈折率が同一の材料からなる凸レンズを形成するものである。

【0023】この発明に係る固体撮像装置の製造方法は、複数の受光部及び電荷転送部を作り込んだ半導体基板上全面に第1の透明絶縁膜をその表面が平坦となるよう堆積した後、該第1の透明絶縁膜上に、上記受光部に対応する部位に開口を有する耐エッチング性膜を形成

し、これをマスクとして第1の透明絶縁膜に等方性エッチングを施して、該透明絶縁膜の、各受光部上の部分に 凹状湾曲面を形成し、続いてこの耐エッチング性膜を除去した後、上記第1の透明絶縁膜上に、該絶縁膜より屈 折率が小さい第2の透明絶縁膜を堆積し、上記第2の透明絶縁膜上の、上記複数の受光部に対応する各領域にそれぞれ、この絶縁膜と屈折率が同一の材料からなる凸レンズを形成するものである。

【0024】この発明に係る固体撮像装置の製造方法は、複数の受光部及び電荷転送部を作り込んだ半導体基板上全面に第1の熱可塑性透明樹脂膜を下地表面の凸凹形状がその表面形状に反映されるよう堆積した後、該第1の熱可塑性透明樹脂膜をリフローしてその受光部上の部分に凹状湾曲面を形成し、次に上記第1の熱可塑性透明樹脂膜上に該樹脂膜より屈折率の小さい第2の透明樹脂膜をその表面が平坦となるよう形成し、上記第2の透明樹脂膜上の、上記複数の受光部に対応する各領域にそれぞれ、この樹脂膜と屈折率が同一の材料からなる凸レンズを形成するものである。

【0025】この発明に係る固体撮像装置の製造方法は、複数の受光部及び電荷転送部を作り込んだ半導体基板上全面に第1の透明絶縁膜をその表面が平坦となるがう堆積した後、上記第1の透明絶縁膜上に、屈折率性透明樹脂を形成し、該熱可塑性透明樹脂を形成し、該熱可塑性透明樹脂を形成し、該熱可塑性透明樹脂のパターニング及び熱リフローを行っな下、上記第1の透明絶縁膜上の、上記複数の受光部に対応する各額以下を形成し、その後該第2の透明絶縁膜を形成し、その後該第2の透明絶縁膜を形成し、その後該第2の透明絶縁膜を形成し、最後に上記第3の透明絶縁膜上の、上記複数の受光部に対応する各領域にそれぞれ、この絶縁膜と屈折率が同一の材料からなる凸レンズを形成するものである。

【0026】この発明は上記固体撮像装置の製造方法において、上記第1の透明絶縁膜上の、上記複数の受光部に対応する各領域にそれぞれ凸レンズを形成した後、上記熱可塑性樹脂より屈折率が大きい光透過膜を、熱リフロー温度よりも低温で下地表面の凹凸形状がその表面形状に反映されるよう堆積するものである。

[0027]

【作用】この発明においては、素子部とレンズ層との間に、屈折率の異なる2つの光透過層を有し、上記レンズ層により集光された入射光をこれが平行光束により近い光束となるよう上記光透過層での屈折により分散する光束分散層を配設したから、上記レンズ層により集光された入射光は、上記光束分散層の通過により集光角度がより小さい集光光束となって受光部に入射することとなる。これにより半導体基板の受光部下側部分での入射光の広がりが抑えられてCCDチャネル領域への光電荷の

漏れ込みが少なくなり、スミアを低減することができる。

【0028】またこの発明においては、上記光束分散層における、光入射側光透過層と光出射側光透過層との接触界面の、受光部上に位置する部分を凹状に湾曲した凹レンズ形状としたので、上記凹状に湾曲した接触界面では入射光の分散は、接触界面がフラットな場合に比べて大きく、上記入射光は、光束調整層の通過によりほぼ平行な光束となって受光部に入射することとなる。これにより半導体基板の受光部下側部分での入射光の広がりはほとんどなくなり、光電荷のCCDチャネル領域への漏れ込みによるスミアの発生をほぼ完全に防止することができる。

【0029】この発明においては、上記光東分散層を、屈折率の小さい光入射側と光出射側の2つの光透過層間に、屈折率の大きい中間光透過層を挟み込んで形成し、光入射側光透過層と中間光透過層との接触界面を全面フラットな形状とし、また中間光透過層と光出射側光透過層と光出射側光透過層との接触界面の、各受光部上の部分を凸状に湾曲した凸レンズ形状としたので、レンズ層により集光された入射光は上記フラットな接触界面と、凸状に湾曲した接触界面とでそれぞれ屈折して分散されることとなる。このため受光部下側の基板部分での入射光の広がりはほとんどなく、上記と同様スミアの発生をほとんど防止することができる。

[0030] この発明においては、上記光東分散層を屈折率の大きい光入射側光透過層と、屈折率の小さい光出射側光透過層とから構成し、上記両光透過層の接触界面の、受光部上の部分を凸状に湾曲した凸レンズ形状としたので、上記レンズ層により集光された入射光は、上記凸状に湾曲した接触界面での屈折により分散されることとなり、これにより上記と同様半導体基板の受光部下側部分での入射光の広がりが抑制されて、光電荷のCCDチャネル領域への漏れ込みによるスミアを低減することができる。

【0031】この発明においては、上記光東分散層として、上記受光部の配列パターンに対応させて複数の凹レンズ部を配列してなる凹レンズアレイ膜を上記素子部上に貼り付け、上記レンズ層として、上記受光部の配列パターンに対応させて複数の凸レンズ部を配列してなる凸レンズアレイ膜を上記凹レンズアレイ膜で集光された入射光は、上記凹レンズアレイ膜での屈折により分散されることとなり、上記と同様にしてスミアの低減を図ることができる。また上記光東分散層及びレンズ層の形成は上記凹レンズアレイ膜及び凸レンズアレイ膜を素子部上に貼り付けるだけでよく、上記各層の形成プロセスが簡単になる。

【0032】この発明においては、複数の受光部及び電荷転送部を作り込んだ半導体基板上の、受光部の周縁部

分に第1の透明絶縁膜の塗布及び異方性エッチングによりサイドウォールを形成し、該サイドウォールを利用して、その受光部上の部分が凹状に湾曲した第2の透明絶縁膜を形成し、該透明絶縁膜上にこれより屈折率の小さい第3の透明絶縁膜を形成することにより、光束分散層を形成するようにしたので、凹状に湾曲した屈折界面を各受光部に対応して有する光束分散層をエッチングマクス等を用いることなく比較的に簡単な工程により形成することができる。

【0033】この発明においては、複数の受光部及び電荷転送部を作り込んだ半導体基板上全面に第1の透明絶縁膜をその表面が平坦となるよう堆積した後、該第1の透明絶縁膜に、耐エッチングマスクを用いた等方性エッチングを施して、該透明絶縁膜の、受光部上の部分に凹状湾曲面を形成し、上記耐エッチングマスクの除去後、上記第1の透明絶縁膜上に、これより屈折率の小さい第2の透明絶縁膜を堆積することにより光東分散層を形成するようにしたので、上記光東分散層の凹状に湾曲した屈折界面の曲率や大きさを上記耐エッチングマスクの開口パターンやエッチング条件等の変更により簡単に調整することができる。

【0034】この発明においては、複数の受光部及び電荷転送部を作り込んだ半導体基板上全面に第1の熱可塑性透明樹脂膜を下地表面の凹凸形状がその表面形状に反映されるよう堆積した後、該透明樹脂膜をリフローしてその受光部上の部分を所定の凹状湾曲形状とし、その上に第1の透明樹脂膜より屈折率の小さい第2の透明樹脂膜を形成することにより、光束分散層を形成するようにしたので、凹状に湾曲した屈折界面を各受光部に対応して有する光束分散層をサイドウォールやエッチングマスク層を用いることなく、比較的に簡単な工程により形成することができる。

【0036】この発明においては、複数の受光部及び電荷転送部を作り込んだ半導体基板上の平坦な第1の透明 絶縁膜上で、熱可塑性透明樹脂のパターニング及び熱リフローを行って、上記第1の透明絶縁膜上の、上記複数 の受光部に対応する各領域にそれぞれ凸レンズを形成し、その後上記熱可塑性樹脂より屈折率が大きい透明材料を、下地表面の凹凸形状がその表面形状に反映されるよう、かつ熱リフロー温度よりも低温で堆積することにより、光束分散層及びレンズ層を形成するようにしたので、上記凸レンズ上の平坦化膜の形成とレンズ層の形成とを1つの工程で行うことができ、製造プロセスを簡略化できる。

[0037]

【実施例】以下、この発明の実施例を図について説明す

実施例1. 図1は本発明の第1の実施例による固体撮像 装置を説明するための断面図で、図13(b) に示す従来 装置のXIVa-XIVa線断面に相当する部分の断面 構造を示している。なお以下の各実施例では、図13 (b) のXIVb-XIVb線断面における素子部上の透 明膜やレンズ層等の構造はXIVa-XIVa線断面の ものと同一であるため、図示していない。

【0038】図において101は本実施例の固体撮像装 置で、この装置101では、素子部201とレンズ層2 0.3との間に、屈折率の異なる2つの光透過層19a, 196の接触界面F1を有し、上記レンズ層203によ り集光された入射光Aの光束を、上記接触界面F1 での 屈折によりこれが平行光束により近い光束となるよう分 散する光束分散層110が配設されている。ここで上記 光入射側光透過層19bはシリコン系樹脂から、上記光 出射側光透過層19aはシリコン窒化膜から構成されて おり、光入射側光透過層19bの屈折率n19b は1.4 ~1.5程度、光出射側光透過層19aの屈折率n19a はシリコン窒化膜の組成比にもよるが約2.0となって いる。その他の構成は従来の固体撮像装置200と同一 であるが、ここでは説明の都合上第2ポリシリコン膜7 bの、CCDチャネル領域上の部分をCCDゲート電極 7としている。

【0039】次に上記固体撮像素子の製造方法について 簡単に説明する。まずN型シリコン基板1にポロン等の P型不純物やリン等のN型不純物を適宜選択的に導入 し、これによりN型シリコン基板1上にP型ウェル領域 2を、その表面に受光部としてのN型半導体層3,N型 CCDチャネル領域4及びP型チャネル分離領域5を形成する(図2(a))。

【0040】次に上記P型ウエル領域2の表面上にシリコン酸化膜6を介して第1及び第2のポリシリコン膜7a、7b(図13(b)、図14(b)参照)を形成し、これをパターニングして上記N型CCDチャネル領域4上にCCDゲート電極7を、またN-型TGチャネル領域4a上にTGゲート電極を形成する(図13(b)参照)。その後アルミ膜の形成とパターニングにより、上記各ゲート電極上にこれに覆い被さるようアルミ遮光膜8を形成し、これにより上記素子部201を完成する

(図2(b))。

【0041】そして上記素子部201上全面にシリコン窒化膜をその表面ができるだけ平坦になるよう、例えばパイアス印加EСR(Electron Cyclotron Resonance)型プラズマCVD法等により堆積して、厚さ $0.1\sim1\mu$ mの光出射側光透過層19aを形成し(図2(c))、続いてその上にシリコン系樹脂を堆積して光入射側光透過層19bを形成する。これにより上記光束分散層110が形成される(図2(d))。

【0042】その後上記光束分散層110上に熱可塑性 樹脂、例えば東京応化株式会社製OFPR-800, 〇 DUR-1010, OEBR-100, 1000等をス ピン塗布法等により塗布し、フォトリソグラフィー技術 等を用いてパターニングして受光部3上の周辺端部を除 去する。これにより平面長方形形状の熱可塑性樹脂10 aが各受光部3上に、垂直CCDの転送方向にはCCD チャネル領域側の中央付近まで、また該転送方向と直角 方向にはP型チャネル分離領域5の中央付近まで広がっ た、平面長方形形状の熱可塑性樹脂層10aが形成され る (図 2 (e))。最後に所定の温度、例えば上記熱可塑 性樹脂としてOFPR-800を用いた場合は、150 ° C前後の温度で上記熱可塑性樹脂層10aを熱リフロ ーすることにより該樹脂層10aを平面長楕円形状の凸 レンズ状に加工してマイクロレンズ10を形成し、固体 撮像装置101を完成する(図2(f))。

【0043】次に作用効果について説明する。一般に、2つの異なる物質の界面では、それらの屈折率に差があると光路しが屈折する。以下図12(a)を用いて詳しく説明する。光が屈折率の小さい物質 I(屈折率 n I)から界面上の点 p Iに入射して、屈折率の大きい物質 I(屈折率 n 2)へ進むとき、点 p Iに立てた法線 m Iと入射光線 m I)がなす角を入射角 m I、法線 m Iと出射光線 m L 2 のなす角を出射角 m m 2、入射光線 m I と出射光線 m L 2 とがなす角度を屈折角 m 3 a とすると、屈折の原理を示す式 m 1 sin m 1 = m 2 sin m 2 よりこの場合 m 1 m 2 であるので、m 1 > m 2 となり、屈折角 m a は m 1 m 2 であるので、m 1 > m 2 となり、屈折角 m a は m 1 m 2 ととなる。

【0044】従って本実施例の固体撮像装置101では、レンズ層203と素子部201との間に、屈折率1.4~1.5の光入射側光透過層19bと屈折率約2.0の光出射側光透過層19aとからなる光束分散層110を設けているため、マイクロレンズ10により集光された入射光Aは上記光束分散層110中の両光透過層19a,19bの接触界面F1での屈折により分散で平行光束に近い光束となる。つまり入射光Aは受光地で平行光束に近い光束となる。つまり入射光Aは受光地のより、ア型ウェル領域2の、受光部3下側の深部での入射光の広がりが抑えられることとなる。これにより受光部3に隣接するCCDチャネル部への光電子の漏れ込みが少なくなり、スミアによる雑音を低減することができ

る。

【0045】ところでこの実施例では、光東分散層110中の、2つの光透過層19a、19bの接触界面Flが全面に渡って平坦な構造となっているため、上記レンズ層203のマイクロレンズ10の屈折率が大きいものでは、上記ウエル2の深部での入射光の広がり抑制がでは、上記ウエル2の深部での入射光の広がり抑制を不十分である場合がある。この場合上記光透過層19a、19bとして風折率の差がより大きな透明材料の選択は必ずしもの表透明材料の選択は必ずしも容易のでであるがあるがように2つの光透過性等から容易のであってそのような透明材料の選択は必ずしも容易のであるが、上記のように2つの光透過を別ればならず、にするためには、屈折率の大きい光出射側光透過を平りまるためには、屈折率の大きい光出射側光透過を平りまるためには、圧が大きい光はなり、受光が大きくなり、受光の感度が低下したのと同様の弊害が生じてしまう。

【0046】実施例2.次にこのような問題点を解決したものとして本発明の第2の実施例による固体撮像装置について説明する。図3は上記第2実施例による固体撮像装置の断面構造を示す図、図4及び図5はそれぞれ該固体撮像装置の第1及び第2の製造方法を説明するための断面図である。図において、102は本実施例の固体撮像装置で、この装置102では上記光束分散層として、屈折率の異なる2つの光透過層の接触界面F2の、受光部上に位置する部分を凹状に湾曲した光束分散層120を備えている。

【0047】ここで上記光束分散層120は、素子部201上に形成され、上記受光部3上に凹状球面部120aを有する光出射側光透過層29と、該光透過層上に形成された光入射側光透過層19bとから構成されており、上記光入射側光透過層29は屈折率が2.0程度のシリコン窒化膜から、また上記光出射側光透過層19bは上記実施例と同様屈折率1.4~1.5程度のシリコン系樹脂から構成されている。その他の構成は上記第1実施例と同一である。

【0048】このような構成の第2の実施例では、素子部201とレンズ層203との間に、屈折率が小さい光入射側光透過層19bと屈折率が大きい光出射側光透過層29とからなり、これらの層の接触界面F2の、受光部上の部分が凹状に湾曲した構造の光束分散層120を配設したので、上記湾曲した接触界面F2では入射光の分散はフラットな接触界面に比べて大きく、上記レンズ層203により集光された入射光Aは、光束分散層120の通過によりほぼ平行光束となって受光部3に入射することとなる。

【0049】 すなわち図12(b) に示すように、光が屈 折率の小さい物質 I (屈折率n1) から、凹状に湾曲し た界面上の点P2 に入射して、屈折率の大きい物質II(屈折率n2) へ進むとき、入射角 $\theta3$, つまり入射点 P2 に立てた法線M2 と入射光線D1 とのなす角度は、 接触界面の平坦部での入射角 θ 1(図12(a)参照)に比べて大きくなり、屈折の一般式n1 \sin θ 3 = n2 \sin n θ 4 から、屈折角 δ b,つまり入射光線L1 と出射光線L2 とのなす角度(θ 3 $-\theta$ 4)も、フラットな接触界面での屈折角 δ a(= θ 1 $-\theta$ 2)に比べて大きくなる。言い換えると上記凹状に湾曲した接触界面での屈折では、平坦な接触界面での屈折に比べて集光光束が発散される度合いが大きく、受光部に入射する入射光はほぼ平行光束となっている。このため半導体基板1の受光電荷のCCDチャネル領域への漏れ込みによるスミアの発生をほぼ完全に防止することができる効果がある。

【0050】またこの実施例では、光出射側光透過層29を構成する光透過率の低いシリコン窒化膜は、上記受光部3上の部分の膜厚が上記実施例のものに比べて薄くなっているため、入射光の減衰量が小さくなり、受光部3での感度が低下した場合に生ずるような弊害を回避することができる。なおこのような観点からは上記シリコン窒化膜の、受光部3上部分の膜厚は零にするのが望ましい。

【0051】次に製造方法について説明する。この実施例の固体撮像装置の製造方法については2つの方法があり、まず上記凹球面部120aを有する光束分散層120の形成に、サイドウォールを用いる第1の方法について図4を用いて説明する。なお、上記素子部201の形成工程は、上記第1実施例の図2(a)及び図2(b)と同一であるため、ここでは省略する。

【0052】図2(a) , (b) に示すように素子部201 を形成した後、第1シリコン窒化膜29a をプラズマC V D 法等によって全面に堆積する(図4(a))。この時シリコン窒化膜29a は、そのエッチパックによるサイドウォールの形成が可能な程度の厚みに形成する必要があり、ここではその厚みは $0.5\sim1.0~\mu$ m程度としている。

【0053】次に、このシリコン窒化膜29aに異方性 エッチングを施してエッチバックし、受光部3の周囲に サイドウォール29a1を形成する(図4(b))。その 後全面に第2シリコン窒化膜29bを、上記サイドウォ ール29alによる下地表面の段差がその表面形状に反 映されるようプラズマCVD法等によって全面に堆積し て、その受光部上の部分120aが凹状に湾曲した厚さ 0. 1~1. 0 μm程度の光出射側光透過層 2 9 を形成 する(図4(c))。その後は上記第1実施例と同様シリ コン系透明樹脂をその表面が平坦となるよう堆積して光 入射側光透過層19bを形成し(図4(d))、続いて上 記第1の実施例装置の製造方法と同様、上記光束調整層 110上に熱可塑性樹脂をスピン塗布法等により塗布 し、フォトリソグラフィー技術等を用いてパターニング してその受光部3上の周辺端部を除去する(図4(e)) .

[0054] そして最後に上記パターニングされた熱可塑性樹脂層10aを所定の温度で熱リフローしてこれを 凸レンズ状に加工し、平面楕円形状のマイクロレンズ1 0を形成する。これにより上記第2実施例の固体撮像装置102を完成する(図4(f))。

【0055】 ここで、上記受光部3の周縁部分上のサイドウォール29alをその一部が受光部3の中央部分を被覆する程度に大きくすることにより、第2のシリコン窒化膜29bを不要とできる。

【0056】このようにこの第1の方法では、素子部201の、受光部3の周縁部分に第1シリコン窒化膜29aの堆積、及びその異方性エッチングによりサイドウォール29alを形成し、その上に第2シリコン窒化膜29bを下地表面の凹凸がその表面形状に反映されるよう堆積し、その後該シリコン窒化膜29bより屈折率の小さいシリコン系透明樹脂を形成することにより、光束分散層120を形成するようにしたので、凹状に湾曲した屈折界面を各受光部に対応して有する光束分散層120をエッチングマクス等を用いることなく比較的に簡単な工程により形成することができる効果がある。

【0057】次に、上記第2の実施例装置を製造するための第2の方法として、上記凹球面部120aを有する光束分散層120の形成に、等方性エッチングを用いる方法について図5を用いて説明する。なおこの方法においても素子部201の形成工程は、上記第1実施例の図2(a)及び図2(b)と同一であるため、ここでは省略する。

【0058】図2(a), (b) に示すように素子部201を形成した後、上記素子部201上にシリコン窒化膜29cをこれができるだけ平坦となるようバイアス印加ECRプラズマCVD法等により堆積する(図5(a))。【0059】次に上記シリコン窒化膜29c上にフォトレジスト31を形成し、これをその開口部31aが上記受光部3上に形成されるようバターニングする(図5(b))。そして該フォトレジスト31をマスクとして上記シリコン窒化膜29cに等方性エッチングを施して、上記シリコン窒化膜29cの、上記受光部3上の部分に凹状湾曲部120aを形成し、光出射側光透過層29を形成する(図5(c))。

【0060】そして、上記フォトレジスト31を除去した後、上記第1実施例と同様にして光入射側光透過層19bを形成し(図5(d))、続いて熱可塑性樹脂10aのスピン塗布、パターニングを行い(図5(e))、最後に上記パターニングされた熱可塑性樹脂層10aを所定の温度で熱リフローしてこれを凸レンズ状に加工し、平面楕円形状のマイクロレンズ10を形成する。これにより上記第2実施例の固体撮像装置102を完成する(図5(f))。

【0061】この方法では、上記サイドウォールを用いる第1の方法に比べて、凹レンズ部の曲率を開口部の大

きさやエッチングの制御によりある程度調整することが できる効果がある。

【0062】このようにこの第2の方法では、素子部201上にシリコン窒化膜29cをその表面が平坦となるよう堆積した後、該窒化膜29cに、耐エッチングマスクを用いた等方性エッチングを施して、該窒化膜29cの、受光部上の部分に凹状湾曲部120aを形成し、記耐エッチングマスクの除去後、上記シリコンを変化膜上に、これより屈折率の小さいシリコン系透明樹脂19bを堆積することにより、光束分散層120を形成するようにしたので、上記光束分散層120の凹状に湾曲した接触界面の曲率や大きさを、上記耐エッチングマスクの開口パターンやエッチング条件等の変更により簡単に調整することができる効果がある。

【0063】なお、この第2の実施例では、上記光出射側光透過層19aとして屈折率が約2.0のシリコン窒化膜を、また光入射側光透過層19bとして屈折率が1.4~1.5程度の透明樹脂を用いているが、上記両光透過層の構成材料はこれに限るものではない。

【0064】実施例2の変形例. 図6は上記第2の実施例の変形例に係る固体撮像装置の製造方法を説明するための図であり、図において102aはこの変形例に係る固体撮像装置で、この装置102aでは、光束分散層120を、屈折率が1.5前後の透明絶縁膜からなる光出射側光透過層29dと、屈折率が1.3前後のフッソ系樹脂からなる光入射側光透過層19cとから構成している。ここでは上記透明絶縁膜29dには、例えばSOG(Spin On Glass)用材料、BPSG(Boron-doped Phospho-Silicate Glass)等のSiO2系材料やPMMA(Poly-Metal-Meta-Acrylate)、PGMA(Poly-Glicydyl-Metal-Metal-Metal-Acrylate)、PGMA(Poly-Glicydyl-Metal-Metal-Metal-Acrylate)、PGMA(Poly

【0065】次に製造方法について説明する。図2(a),(b)に示すように素子部201を形成した後、受光部3とその周辺のアルミ遮光膜8及び第2ポリシリコン7b(図14(b)参照)との間に段差が形成されている状態で、透明樹脂膜29d1を下地表面の段差形状がその表面形状に反映されるようにプラズマCVD、スピン塗布法等により積層し(図6(a))、熱リフローによりその受光部上の平面略正方形形状の凹状部分120aを所望の凹状球面形状として、光出射側光透過層29dを形成する(図6(b))。

【0066】次に上記光出射側光透過層29d上に屈折率が1.3前後のフッ素系樹脂をスピン塗布法等により、その表面が充分平坦となるよう厚く塗布して、光入射側光透過層19cを形成する(図6(c))。

【0067】その後は上記第2実施例の各方法と同様、 熱可塑性樹脂のスピン塗布、バターニングを行い(図6 (d))、上記バターニングされた熱可塑性樹脂層10a を所定の温度で熱リフローしてこれを凸レンズ状に加工し、マイクロレンズ 10を形成する。これにより上記第2実施例の固体撮像装置 102 aを完成する(図6(e))。

【0068】このように第2実施例の変形例では、素子部201上に透明絶縁膜29d1を下地表面の凹凸形状がその表面形状に反映されるよう堆積した後、該透明絶縁膜29d1の熱リフローによりその受光部上の凹状部分120aを所定の凹状湾曲形状として光出射側光透過層29dを形成し、その上に上記透明絶縁膜29d1より屈折率の小さいフッソ系透明樹脂(光入射側光透過層)19cを形成することにより、光東分散層120を形成するようにしたので、凹状に湾曲した凹レンズ部120aを各受光部に対応して有する光東分散層120をサイドウォールやエッチングマスク層を用いることなく、比較的に簡単な工程により形成することができる効果がある。

【0069】実施例3.図7は本発明の第3の実施例による固体撮像装置を示す断面図であり、図において、103は本実施例の固体撮像装置で、その光東分散層130は、素子部201上に形成された、その表面が平坦な光出射側光透過層39aと、該膜39a上の、受光部3上に位置する部分に配設された、CCD転送方向をその短軸方向とする平面楕円形状の補助凸レンズ11と、上記光出射側光透過層39a及び補助凸レンズ11上全面に形成された、その表面が平坦な中間光透過層39bと、その上に形成されたその表面が平坦な光入射側光透過層39cとから構成されている。

【0070】ここで上記各光透過層39a、39c及び補助凸レンズ11は屈折率が1.5程度のポリマーから構成されており、また中間光透過層39bは屈折率が1.9程度のシリコン窒化膜から構成されている。またレンズ層203を構成するマイクロレンズ10も屈折率1.5程度のポリマーで構成されている。その他の構成は上記第1実施例の固体撮像装置101と同一である。【0071】なお図中、F3aは上記補助凸レンズ111と中間光透過層39bとの凸状に湾曲した接触界面を、F3bは上記中間光透過層39bと光入射側光透過層39cとのフラットな接触界面を示しており、またn39a、n39b,n39cは上記各光透過層39a、39b、39cの屈折率、n11は補助凸レンズ11の屈折率を示している。

【0072】次に製造方法について説明する。上記素子部201の形成を上記各実施例と同様図2(a),図2(b)に示すように行った後、上記素子部201上に、例えばSOG等の酸化膜あるいはPMMA、PGMA等のポリマーを、その表面が平坦になるようスピン塗布して、屈折率1.5前後の光出射側光透過層39aを形成する(図8(a))。

【0073】次に上記光出射側光透過層39a上に、例

えば東京応化株式会社製〇FPR-800、〇DUR-1010、〇EBR-100、1000等の熱可塑性樹脂をスピン塗布法等により塗布し、フォトリソグラフィ技術等を用いて受光部3上の周辺端部を除去する(図8(b))。

[0074] 続いて所定の温度で熱リフロー処理を行って上記パターニングされた熱可塑性樹脂層11aを変形させて上記補助凸レンズ11を形成する(図8(c))。ここで処理温度は例えば、上記熱可塑性樹脂としてOFPR-800を用いた場合なら、150° c前後とする。

【0075】次にバイアス印加ECR型プラズマCVD法により、上記熱リフロー温度以下でシリコン窒化膜を上記光出射側光透過層39a及び補助凸レンズ11上全面に堆積して、その表面が平坦な中間光透過層39bを形成し、続いてこの中間光透過層39b上に、光出射側光透過層39aと同様、酸化膜あるいはポリマーをスピン塗布して、屈折率1.5前後の光入射側光透過層39cを形成する(図8(d))。

【0076】その後熱可塑性樹脂の塗布及びパターニングを上記補助凸レンズ11の形成工程と同様に行い(図8(e))、所定の温度で熱リフロー処理を施して平面楕円形状のマイクロレンズ10を形成し、固体撮像装置103を完成する(図8(f))。

【0077】次に作用効果について説明する。このような構成の第3の実施例装置では、上記光束分散層130を、屈折率の小さい光入射側と光出射側の2つの光透過層39a、39cと、これらの間に介在する屈折率の大きい中間光透過層39bとから構成し、光入射側光透過層39cと中間光透過層39bとがら構成し、光入射側光透過層39cと中間光透過層39bと光出射側光透過層39aとの接触界面の、各受光部上の部分を凸状に満曲した凸レンズ形状としたので、レンズ層203により集光された入射光は上記フラットな接触界面F3bと、凸状に満曲した接触界面F3aとでそれぞれ屈折して分散されることとなる。

【0078】すなわち、上記フラットな接触界面F3bでは、図12(a)に示すように入射光は屈折率の小さい物質Iから入射して、屈折率の大きい物質II中に進むこととなり、集光光束はその界面通過後、より平行光束に近い光束となる。また湾曲した接触界面F3aでは、図12(c)に示すように入射光は屈折率の大きい物質III(屈折率n3)から入射して、屈折率の小さい物質IV(屈折率n4)中に進むこととなる。この時、入射点P3に立てた法線M3と入射光線L1とのなす角度を入射角 θ 5、法線M3と出射光線L2とのなす角度を出射角 θ 6

、入射光線L1 と出射光線L2 とがなす角度を屈折角 δ c とすると、屈折の一般式 n3 sin θ 5 = n4 sin θ 6 から、この場合 n3 > n4 であるので、 θ 5 < θ 6 となり、屈折角 δ c は θ 6 $-\theta$ 5となる。言い換えると、

上記凸状に湾曲した接触界面での屈折では、入射光Aはその界面通過後やはり、より平行光束に近い光束となる。このため受光部下側の基板部分での入射光の広がりはほとんどなく、上記と同様スミアの発生をほとんど防止することができる効果がある。

[0079] また上記表面が平坦な光入射側及び光出射側の光透過層39a,39cは、光路長をかせいで屈折光がより多く受光部に到達するためのもので、これらの光路長の調整可能な光透過層を用いることにより、マイクロレンズ10や補助凸レンズ11を、曲率等について固体撮像装置の仕様上からの制約を受けることなく、製造プロセス上最も高精度に形成可能な形状にすることができる。但しこれらの層がなくても本発明の、スミア低減という基本的な効果は変わらない。

【0080】実施例3の変形例. 図9は、上記第3実施例の変形例による固体撮像装置を示す断面図であり、図において、103aは本変形例の固体撮像装置で、その光束分散層130aは、素子部201上に形成された、その表面が平坦な光出射側光透過層39aと、該膜39a上の、受光部3上に位置する部分に配設された補助凸レンズ11上全面に、下地表面の凹凸形状がその表面形状に反映されるよう形成された光入射側光透過層39dとから構成されている。従ってここではレンズ層203は上記光入射側光透過層39dの表面の凸状部分から構成されている。

【0081】ここで上記光出射側光透過層39a及び補助凸レンズ11は屈折率が1.5程度のポリマーから構成されており、また光入射側光透過層39dは屈折率が1.9程度のシリコン窒化膜から構成されている。その他の点は上記第3実施例と同一である。なお図中、F3aは上記補助凸レンズ11と中間光透過層39bとの湾曲した接触界面であり、n39dは上記光透過層39dの屈折率を示している。

【0082】次に製造方法について説明する。上記第3の実施例装置の製造方法で説明したように、上記素子部201を形成した後、光出射側光透過層39aの形成(図10(a))及び補助凸レンズ11の形成(図10(b),(c))を順次行い、ECRプラズマCVDによりシリコン窒化膜を、下地表面の凹凸形状がその表面形状に反映されるよう上記熱リフロー温度以下で堆積して、光束分散層130a及びレンズ層203を形成する。これにより第3実施例の変形例に係る固体撮像装置103aを形成する(図10(d))。

【0083】このような構成の第3実施例の変形例では、光東分散層130aを、屈折率の大きい光入射側光透過層39dと、屈折率の小さい光出射側光透過層39aとから構成し、上記両光透過層の接触界面の、上記受光部上の部分F3aを凸状に湾曲した凸レンズ形状としたので、レンズ層203により集光された入射光は、図1

2(c) を用いて説明したように、上記凸状に湾曲した接触界面F3aでの屈折により分散されることとなる。これにより受光部下側の基板部分での入射光の広がりを抑えて、スミアの発生を低減することができる効果がある。

【0084】また熱可塑性樹脂からなる光出射側光透過層39a上の、上記複数の受光部3に対応する各領域にそれぞれ補助凸レンズ11を形成した後、上記熱可塑性樹脂より屈折率が大きいシリコン窒化膜を、下地表面の凹凸形状がその表面形状に反映されるよう、かつ熱フロー温度よりも低温で堆積して、光束分散層130a及びレンズ層203を形成するようにしたので、上記補助凸レンズ11上の平坦化膜の形成とレンズ層203との形成を1つの工程で行うことができ、製造プロセスを簡略化できる効果がある。

[0085] 実施例4. 図11は本発明の第4の実施例による固体撮像装置を説明するための断面図であり、図11(a) は素子部に光束分散層及びレンズ層を取り付ける様子を、また図11(b) は固体撮像装置の完成状態を示している。

【0086】図において、104は本実施例の固体撮像装置で、ここでは光束調整層として、素子部201上に貼り付けられた凹レンズアレイ膜140を用い、レンズ層として、該凹レンズアレイ膜上に貼り付けられた凸レンズアレイ膜150を用いている。

【0087】ここで上記凹レンズアレイ膜140は、上記受光部3の2次元アレイと同一ピッチで配列された複数の凹レンズ部141からなり、上記凸レンズアレイ膜150は、受光部の2次元アレイと同一ピッチで配列された複数の凸レンズ部151からなっており、上記各レンズ部の平面形状はCCDの転送方向を短軸方向とする平面楕円形状となっている。また各レンズアレイ膜は素子部201とは全く別に製造されたもので、固体撮像装置の用途等に合わせてそのレンズ部の曲率を異ならせたいくつかの種類のものが用意されている。

【0088】その製造方法は、上記半導体基板上に素子部201を形成した後、全面に平坦化膜9を形成し(図11(a))、その後凹レンズ部141が所定の曲率を持つ凹レンズアレイ膜140を接着材により貼り付け、さらにその上に凸レンズ部151が所定の曲率を持つ凸レンズアレイ膜150を貼り付けて、上記固体撮像装置104を完成する(図11(b))。

【0089】このような構成の本実施例では、レンズ層としての凸レンズアレイ膜150で集光された入射光が、光束分散層としての凹レンズアレイ膜140での屈折により分散されることとなる。これにより受光部下側の基板部分での入射光の広がりを抑えて、スミアの発生を低減することができる効果がある。

【0090】また素子部201を形成し、その表面を平 坦化した後は、既成のレンズアレイ膜を貼り付けるだけ で固体撮像装置を完成することができ、レンズ層の曲率 を製造プロセス上の制約を受けることなく自由に選択することができる。またこのため素子部の機能が異なる固体撮像装置を何種類も製造する場合には、各素子部についての、レンズ層や光束分散層を形成するプロセスを大幅に時間短縮することができる。

[0091]

【発明の効果】以上のようにこの発明に係る固体撮像装置によれば、素子部とレンズ層との間に、屈折率の異なる2つの光透過層を有し、上記レンズ層により集光された集光光束をこれが平行光束により近い光束となるう上記光透過層での屈折により分散する光束分散層を配設したので、上記レンズ層により集光された入射光は、上記光束調整層の通過により集光角度がより小さい集光光束となって受光部に入射することとなり、これにより半導体基板の受光部下側部分での入射光の広がりが抑えられてCCDチャネル領域への光電荷の漏れ込みが少なくなり、スミアを低減することができる効果がある。

【0092】またこの発明によれば上記固体撮像装置において、上記光束分散層における、光入射側光透過層と光出射側光透過層との接触界面の、受光部上に位置する部分を凹状に湾曲した凹レンズ形状としたので、上記湾曲した接触界面では入射光の分散は接触界面がフラットな場合に比べて大きく、上記レンズ層により集光された入射光は、光束分散層の通過によりほぼ平行光束となって受光部に入射することとなり、これにより半導体基板の受光部下側部分での入射光の広がりはほとんどなくなり、光電荷のCCDチャネル領域への漏れ込みによるスミアの発生をほぼ完全に防止することができる効果がある。

【0093】またこの発明によれば上記固体撮像装置において、上記光東分散層を、屈折率の小さい光入射側と光出射側の2つの光透過層間に、屈折率の大きい中間光透過層を挟み込んで形成し、光入射側光透過層と中間光透過層との接触界面を全面フラットな形状とし、また中間光透過層と光出射側光透過層との接触界面の、各受光部上の部分を凸状に湾曲した凸レンズ形状としたので、レンズ層により集光された入射光は上記フラットな接触界面と、凸状に湾曲した接触界面とでそれぞれ屈折して分散されることとなり、このため受光部下側の基板部分での入射光の広がりはほとんどなく、上記と同様スミの発生をほとんど防止することができる効果がある。

【0094】さらにこの発明によれば上記固体撮像装置において、上記光束分散層を屈折率の大きい光入射側光透過層と、屈折率の小さい光出射側光透過層とから構成し、上記両光透過層の接触界面の、受光部上の部分を凸状に湾曲した凸レンズ形状としたので、上記レンズ層により集光された入射光は、上記凸状に湾曲した接触界面での屈折により分散されることとなり、これにより上記と同様半導体基板の受光部下側部分での入射光の広がりが抑制されて、光電荷のCCDチャネル領域への漏れ込

みによるスミアを低減することができる効果がある。

٠.

【0095】この発明によれば上記固体撮像装置において、上記光束分散層として、上記受光部の配列パターンに対応させて複数の凹レンズ部を配列してなる凹レンズアレイ膜を上記素子部上に貼り付け、上記レンズ層として、上記受光部の配列パターンに対応して複数の凸レンズアレイ膜上に貼り付けたので、上記凸レンズアレイ膜での屈折により分散されることとなり、上記と同様にしてスミアの低減を図ることができる効果がある。また光束分散層やレンズ層の形成は上記凹レンズアレイ膜、凸レンズアレイ膜を素子部上に貼り付けるだけでよく、製造プロセスが簡単になる効果がある。

【0096】この発明に係る固体撮像装置の製造方法によれば、複数の受光部及び電荷転送部を作り込んだ半導体基板上の、受光部の周縁部分に第1の透明絶縁膜の塗布及び異方性エッチングによりサイドウォールを形成し、該サイドウォールを利用して、その受光部上の部分が凹状に湾曲した第2の透明絶縁膜を形成し、該透明絶縁膜上にこれより屈折率の小さい第3の透明絶縁膜を形成することにより、光東分散層を形成するようにしたので、凹状に湾曲した屈折界面を各受光部に対応して有する光東分散層をエッチングマクス等を用いることなく比較的に簡単な工程により形成することができる効果がある。

【0097】この発明に係る固体撮像装置の製造方法によれば、複数の受光部及び電荷転送部を作り込んだ半導体基板上全面に第1の透明絶縁膜をその表面が平坦となるよう堆積した後、該第1の透明絶縁膜に、耐エッチングマスクを用いた等方性エッチングを施して、該透明といいでは、上記第1の透明絶縁膜上に、これより屈折率の小さい第2の透明絶縁膜を堆積っていまり光東分散層を形成するようにしたので、上記光東分散層の凹状に湾曲した屈折界面の曲率や大きな記光東分散層の凹状に湾曲した屈折界面の曲率や大き体等の変更により簡単に調整することができる効果がある。

【0098】この発明に係る固体撮像装置の製造方法によれば、複数の受光部及び電荷転送部を作り込んだ半導体基板上全面に第1の熱可塑性透明樹脂膜を下地表面の凹凸形状がその表面形状に反映されるよう堆積した後、筋第1の透明樹脂膜をリフローしてその受光部上の砂膜を所定の凹状湾曲形状とし、その上に上記透明絶縁により屈折率の小さい第2の透明樹脂膜を形成することが開起を形成するようにしたので、凹状に満足した屈折界面を各受光部に対応して有する光束分散層をサイドウォールやエッチングマスク層を用いることなく、比較的に簡単な工程により形成することができる効

果がある。

[0099] この発明に係る固体撮像装置の製造方法によれば、複数の受光部及び電荷転送部を作り込んだ半導体基板上の平坦な第1の透明絶縁膜上に、熱可塑性透明樹脂のバターニング及び熱フローを行って、上記複数の受光部に対応する各領領地とれぞれ凸レンズを形成し、その後全面に上記熱可したを形成し、その後全面に上記熱可したが下さい透明を形成し、表面が平坦となるよう堆積して第2の透明絶縁膜を形成し、その後第2の透明絶縁膜を形成し、第3の透明絶縁膜を形成するようにしたので、上記等はより屈折率の小さい第3の透明絶縁膜を形成するよりにしたので、上記等によりを明絶縁膜上の凸レンズはプロセス上最のではより、光東分散層を形成するようにしたので、上記号により、光東分散層を形成するようにしたので、上記号により、光東分散層を形成である。

【0100】この発明によれば上記固体撮像装置の製造方法において、第1の透明絶縁膜上の、上記複数の受光部に対応する各領域にそれぞれ補助凸レンズを形成した後、上記熱可塑性樹脂より屈折率が大きい透明材料を、下地表面の凹凸形状がその表面形状に反映されるよう、かつ熱フロー温度よりも低温で堆積することにより、光東分散層及びレンズ層を形成するようにしたので、上記補助凸レンズ上の平坦化膜の形成とレンズ層の形成とを1つの工程で行うことができ、製造プロセスを簡略化できる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の第1の実施例による固体撮像装置の 構造を示す断面図である。

【図2】上記固体撮像装置の製造方法を主要工程別に説明するための断面図である。

【図3】この発明の第2の実施例による固体撮像装置の 構造を示す断面図である。

【図4】上記第2実施例装置の製造方法として光束分散 層の形成にサイドウォールを用いる方法を説明するため の図である。

【図5】上記第2実施例装置の製造方法として光束分散 層の形成に等方性エッチングを用いる方法を説明するた めの図である。

【図6】上記第2実施例の変形例による固体撮像装置の 製造方法を主要工程別に説明するための断面図である。

【図7】この発明の第3の実施例による固体撮像装置の 構造を示す断面図である。

【図8】この第3実施例の固体撮像装置を製造する方法 を主要工程別に説明する断面図である。

[図9]上記第3実施例の変形例による固体撮像装置の 構造を示す断面図である。

[図10]上記第3実施例の変形例の固体撮像装置を製造する方法を主要工程別に説明する断面図である。

【図11】本発明の第4の実施例による固体撮像装置の

構造を示す断面図である。

【図12】屈折率の異なる物質の界面で光路が屈折する 様子を示す図である。

【図13】従来の固体撮像装置における基板上での拡散 領域等のレイアウトを示す平面図である。

【図14】従来の固体撮像装置の断面構造を示す図である。

【符号の説明】

- 1 N型シリコン基板
- 2 P型ウェル領域
- 3 受光部
- 4 N型CCDチャネル領域
- 5 P型チャネル分離領域
- 6 ゲート絶縁膜
- 7 a 第1ポリシリコン膜
- 7 b 第2ポリシリコン膜
- 8 アルミ遮光膜

10 マイクロレンズ

11 補助凸レンズ

19a, 29, 29d, 39a 光出射側光透過層

19b, 19c, 39c, 39d 光入射側光透過層

39b 中間光透過層

101, 102, 102a, 103, 103a, 104 固体撮像装置

110, 120, 130, 130a 光束分散層

140 凹レンズアレイ膜

150 凸レンズアレイ膜

201 案子部

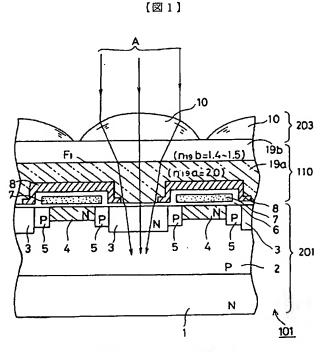
203 レンズ層

A 入射光

E0 受光部の直下で発生する光電子

El 受光部端で発生する光電子

F1, F2, F3a, F3b 接触界面



1:N型シリコン基板

2:P型ウェル領域

3: 受光部

4:N型CCD 和礼領核

5:P型 分利分離領域 6:ケート 絶縁膜

7:ケーを極

8:アルミ 遮光膜

10:マイクロレンズ

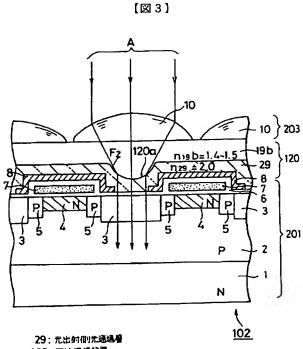
190:光出射例光选過層

196:光入射侧光透過層

101: 固体機像裝置 110: 光束分散層

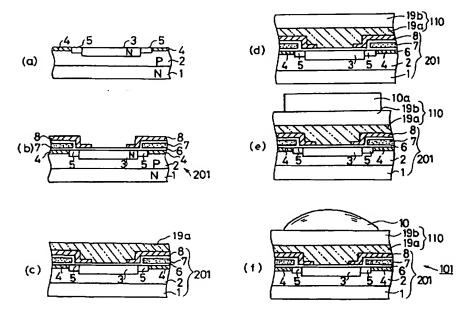
201:煮子部

203: レンス層

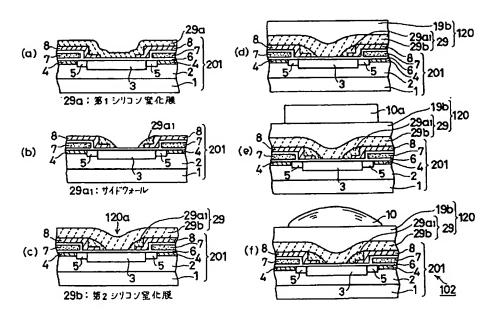


102: 固体接條設置 120: 光束分數層 120a: 21状清曲面

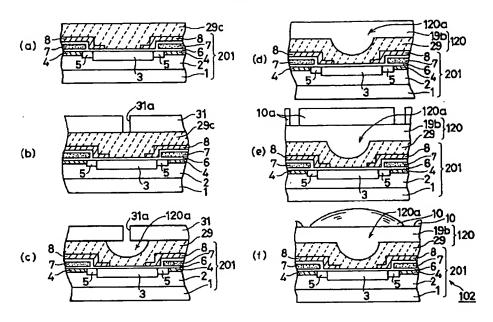
[図2]



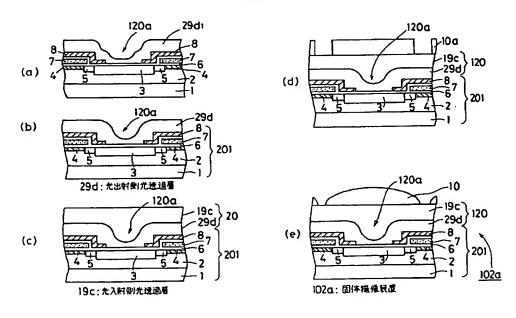
[図4]

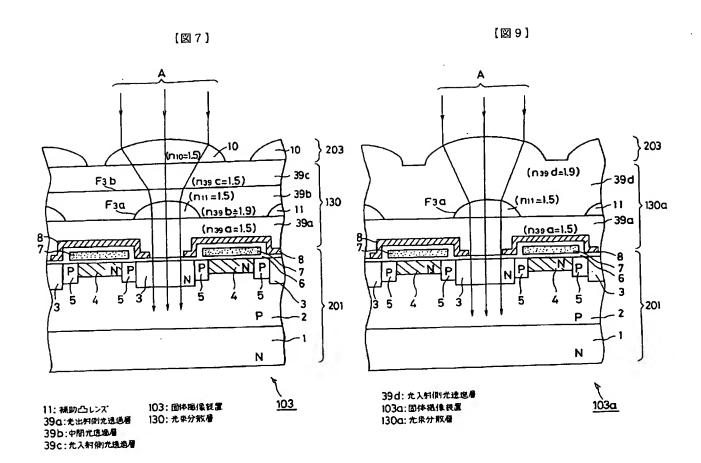


【図5】

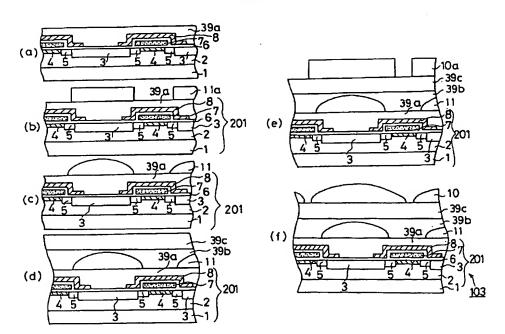


[図6]



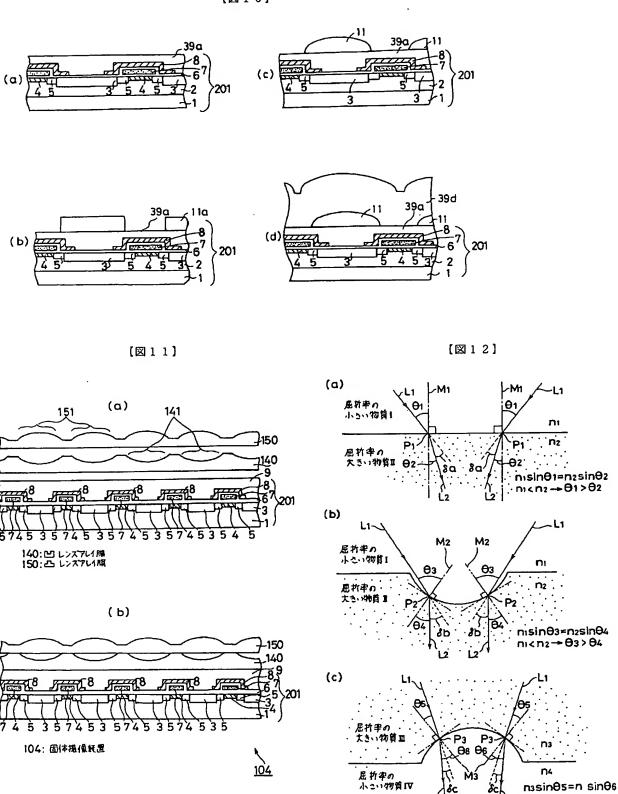


[図8]

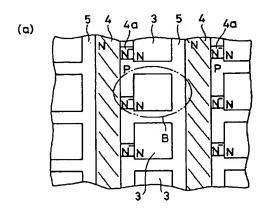


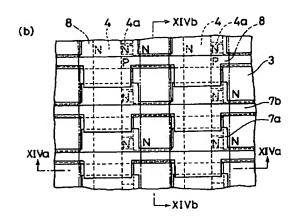
n₃ > n₄ → θ₅ < θ₆

[図10]

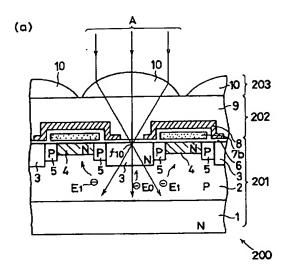


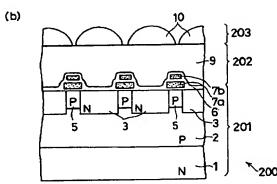
【図13】





【図14】





【手続補正書】

【提出日】平成5年7月14日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0007

【補正方法】変更

【補正内容】

【0007】また光路長調整層202は、上記アルミ遮光膜8上全面に形成され、透明樹脂からなる平坦化膜9であり、上記レンズ層203は、この平坦化膜9上の、上記複数の受光部3に対応する各領域に配設され、入射光Aを各受光部に集める凸形マイクロレンズ10から構成されている。またここでは上記マイクロレンズ10は、その中心が受光部の中心に位置するように配置されており、またその形状は、図13(a)の二点鎖線Bで示すようにCCDチャネル領域4側に張り出した平面楕円形状となっている。従って、受光部3の周辺領域・つまりN型CCDチャネル領域4、N型TGチャネル領域4a及びP型チャネル分離領域5上に降り注ぐ入射光も上

記受光部3に導入できるようになっている。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正内容】

[0009] そして上記集光した光によって受光部3で発生した光電子は受光部3に蓄積され、所定のタイミングでもってGチャネル領域4aを通してCCDチャネル領域4へ移され、CCDの転送動作により後段の信号処理装置に出力される。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正内容】

[0012] なお、このように素子部上に透明絶緑層を 介してレンズ層を形成してなる固体撮像装置は、特開昭 61-64158号公報,特開平2-103962号公報,特開平2-280376号公報,特開昭60-145776号公報,特開平2-65171号公報等にも示されており、特に特開昭61-64158号公報,特開平2-280376号公報,特開平2-65171号公報記載の固体撮像装置は、上記従来の固体撮像装置200と同様、受光部や電荷転送部を形成した半導体基板上に透明膜を介して集光レンズを形成してなるもので、これらの装置では、基板の受光部下側部分での入射光の広がりにより、スミアが発生するという上記と同様な問題がある。

【手続補正4】

٠.

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0025

【補正方法】変更

【補正内容】

【0025】この発明に係る固体撮像装置の製造方法 は、複数の受光部及び電荷転送部を作り込んだ半導体基 板上全面に第1の透明絶縁膜をその表面が平坦となるよ う堆積した後、上記第1の透明絶縁膜上に、屈折率がこ れと同一の熱可塑性透明樹脂膜を形成し、該熱可塑性透 明樹脂膜のパターニング及び熱リフローを行って、上記 第1の透明絶縁膜上の、上記複数の受光部に対応する各 領域にそれぞれ凸レンズを形成し、その後全面に上記熱 可塑性樹脂膜より屈折率が大きい透明な材料を上記熱り フロー温度よりも低温で、その表面が平坦となるよう堆 積して第2の透明絶縁膜を形成し、その後該第2の透明 絶縁膜上にこれより屈折率の小さい第3の透明絶縁膜を 形成し、最後に上記第3の透明絶縁膜上の、上記複数の 受光部に対応する各領域にそれぞれ、この絶縁膜と屈折 率が同一の材料からなる凸レンズを形成するものであ る。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0026

【補正方法】変更

【補正内容】

【0026】この発明は上記固体撮像装置の製造方法において、上記第1の透明絶縁膜上の、上記複数の受光部に対応する各領域にそれぞれ凸レンズを形成した後、上記熱可塑性樹脂膜より屈折率が大きい透明材料を、熱リフロー温度よりも低温で下地表面の凹凸形状がその表面形状に反映されるよう堆積するものである。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

【補正内容】

【0028】またこの発明においては、上記光束分散層における、光入射側光透過層と光出射側光透過層との接触界面の、受光部上に位置する部分を凹状に湾曲した凹

レンズ形状としたので、上記凹状に湾曲した接触界面では入射光の分散は、接触界面がフラットな場合に比べて大きく、上記入射光は、光束分散層の通過によりほぼ平行な光束となって受光部に入射することとなる。これにより半導体基板の受光部下側部分での入射光の広がりはほとんどなくなり、光電荷のCCDチャネル領域への漏れ込みによるスミアの発生をほぼ完全に防止することができる。

【手続補正7】

【補正対象暬類名】明細暬

【補正対象項目名】0042

【補正方法】変更

【補正内容】

【0042】その後上記光束分散層110上に熱可塑性 樹脂、例えば東京応化株式会社製〇FPR-800, 〇 DUR-1010, OEBR-100, 1000等をス ピン塗布法等により塗布し、フォトリソグラフィー技術 等を用いてパターニングして受光部3上の周辺端部を除 去する。これにより各受光部3上に、垂直CCDの転送 方向にはCCDチャネル領域側の中央付近まで、また該 転送方向と直角方向にはP型チャネル分離領域 5 の中央 付近まで広がった、平面長方形形状の熱可塑性樹脂層1 0 a が形成される (図 2 (e)) 。最後に所定の温度、例 えば上記熱可塑性樹脂としてOFPR-800を用いた 場合は、150° C前後の温度で上記熱可塑性樹脂層1 0 a を熱リフローすることにより該樹脂層 1 0 a を平面 長楕円形状の凸レンズ状に加工してマイクロレンズ10 を形成し、固体撮像装置101を完成する(図 2 (f)) .

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0045

【補正方法】変更

【補正内容】

【0045】ところでこの実施例では、光東分散層110中の、2つの光透過層19a,19bの接触界面Flが全面に渡って平坦な構造となっているため、上記レンズ層203のマイクロレンズ10の屈折率が大きいものでは、上記ウエル2の深部での入射光の広がり抑制が不十分である場合がある。この場合上記光透過層19a,19bとして屈折率の差がより大きな透明材料を用いる必要があるが、製造プロセスや光透過性等からの制度であるが、製造プロセスや光透過性等からの制度があってそのような透明材料の選択は必ずしも容易で面を対している。また、上記のように2つの光透過層の接触界面を知りまた。上記のように2つの光透過層の接触界面を担にするためには、屈折率の大きい光出射側光透過厚19aを構成する、光透過性の悪いシリコン窒化膜を平坦にするためには、屈折率の大きい光出射側光透過厚しなければならず、この結果光東分散層での入射光の複数が大きくなり、受光部3の感度が低下したのと同様の数害が生じてしまう。

【手続補正9】

【補正対象費類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 4 7

【補正方法】変更

【補正内容】

【0047】ここで上記光束分散層120は、素子部201上に形成され、上記受光部3上に凹状球面部120aを有する光出射側光透過層29と、該光透過層上に形成された光入射側光透過層19bとから構成されており、上記光出射側光透過層29は屈折率が2.0程度のシリコン窒化膜から、また上記光入射側光透過層19bは上記実施例と同様屈折率1.4~1.5程度のシリコン系樹脂から構成されている。その他の構成は上記第1実施例と同一である。

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0053

【補正方法】変更

【補正内容】

[0053] 次に、このシリコン窒化膜29aに異方性エッチングを施してエッチバックし、受光部3の周囲にサイドウォール29alを形成する(図4(b))。その後全面に第2シリコン窒化膜29bを、上記サイドウォール29alによる下地表面の段差がその表面形状に向中されるようプラズマCVD法等によって全面に堆積で、その受光部上の部分120aが凹状に湾曲したたり、その受光部上の部分120aが凹状に湾曲したたり。その後は上記第1実施例と同様にでいる。その後は上記第1実施例と同様にでいる。その後は上記第1実施例と同様により立るは、大射側光透過層19bを形成し(図4(d))、続いりコン系透明樹脂をその表面が平坦となるよう堆積している場別光透過層19bを形成し(図4(d))、続いり、続いり、続いり、続いり、大力をでしていまり、というでは、上記光分散を用いてパターニングラフィー技術等を用いてパターニングしてその受光部3上の周辺端部を除去する(図4(e))。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0064

【補正方法】変更

【補正内容】

【0064】実施例2の変形例. 図6は上記第2の実施例の変形例に係る固体撮像装置の製造方法を説明するための図であり、図において102aはこの変形例に係る固体撮像装置で、この装置102aでは、光束分散層120を、屈折率が1.5前後の透明絶縁膜からなる光出射側光透過層29dと、屈折率が1.3前後のフッソ系樹脂からなる光入射側光透過層19cとから構成している。ここでは上記透明絶縁膜29dには、例えばSOG(Spin On Glass)用材料、BPSG(Boron-doped Phospho-Silicate Glass)等のSiO2系材料やPMMA(Poly-Methyl-Meta-Acrylate)、PGMA(Poly-Glicydyl-Meta-Acrylate)等のポリマーであって屈折率が1.5前

後のものを用いている。その他の点は上記第2の実施例 装置と全く同一である。

【手続補正12】

【補正対象曹類名】明細書

【補正対象項目名】0069

【補正方法】変更

【補正内容】

【0069】実施例3.図7は本発明の第3の実施例による固体撮像装置を示す断面図であり、図において、103は本実施例の固体撮像装置で、その光東分散層130は、光出射側光透過層39aと、上記光透過層39aと全面に形成された、その表面が平坦な中間光透過層39bと、その上に形成されたその表面が平坦な光入射側光透過層39cとから構成されており、ここでは光出射側光透過層39aは素子部201上に形成された、その表面が平坦な光透過層39alと、該膜39al上の、受光部3上に位置する部分に配設された、CCD転送方向をその短軸方向とする平面楕円形状の補助凸レンズ11から構成されている。

【手続補正13】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 7 0

【補正方法】変更

【補正内容】

【0070】ここで上記各光透過層39a1、39c及び補助凸レンズ11は屈折率が1.5程度のポリマーから構成されており、また中間光透過層39bは屈折率が1.9程度のシリコン窒化膜から構成されている。またレンズ層203を構成するマイクロレンズ10も屈折率1.5程度のポリマーで構成されている。その他の構成は上記第1実施例の個体撮像装置101と同一である。

【手続補正14】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0071

【補正方法】変更

【補正内容】

【0071】なお図中、F3aは上記補助凸レンズ11と中間光透過層39bとの凸状に湾曲した接触界面を、F3bは上記中間光透過層39bと光入射側光透過層39cとのフラットな接触界面を示しており、またn39al, n39b, n39c は上記各光透過層39al, 39b, 39cの屈折率、n!lは補助凸レンズ11の屈折率を示している。

【手続補正15】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0072

【補正方法】変更

【補正内容】

[0072] 次に製造方法について説明する。上記素子 部201の形成を上記各実施例と同様図2(a),図2 (b) に示すように行った後、上記素子部201上に、例えばSOG等の酸化膜あるいはPMMA、PGMA等のポリマーを、その表面が平坦になるようスピン塗布して、屈折率1.5前後の<u>平坦な</u>光透過層39a<u>1</u>を形成する(図8(a))。

【手続補正16】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0073

【補正方法】変更

【補正内容】

【0073】次に上<u>記光</u>透過層39a<u>1</u>上に、例えば東京応化株式会社製OFPR-800, ODUR-1010, OEBR-100, 1000等の熱可塑性樹脂をスピン塗布法等により塗布し、フォトリソグラフィ技術等を用いて受光部3上の周辺端部を除去する(図8(b))。

【手続補正17】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0074

【補正方法】変更

【補正内容】

【手続補正18】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0075

【補正方法】変更

【補正内容】

【0075】次にバイアス印加ECR型プラズマCVD法により、上記熱リフロー温度以下でシリコン窒化膜を上記光出射側光透過層39<u>a上</u>全面に堆積して、その表面が平坦な中間光透過層39bを形成し、続いてこの中間光透過層39b上に、上記光透過層39a<u>1</u>と同様、酸化膜あるいはポリマーをスピン塗布して、屈折率1.5前後の光入射側光透過層39cを形成する(図8(d))。

【手続補正19】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0077

【補正方法】変更

【補正内容】

[0077] 次に作用効果について説明する。このような構成の第3の実施例装置では、上記光束分散層130を、屈折率の小さい光入射側と光透過層39cと、平坦な光透過層39al,及び補助レンズ11からなる光出射側光透過層39aと、これらの間に介在する屈折率の

大きい中間光透過層39bとから構成し、光入射側光透過層39cと中間光透過層39bとの接触界面を全面フラットな形状とし、また中間光透過層39bと光出射側光透過層39aとの接触界面の、各受光部上の部分を凸状に湾曲した凸レンズ形状としたので、レンズ層203により集光された入射光は上記フラットな接触界面F3bと、凸状に湾曲した接触界面F3aとでそれぞれ屈折して分散されることとなる。

【手続補正20】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0079

【補正方法】変更

【補正内容】

【0079】また上記表面が平坦な光入射側及び光出射側の光透過層39<u>c</u>,39<u>a1</u>は、光路長をかせいで屈折光がより多く受光部に到達するためのもので、これらの光路長の調整可能な光透過層を用いることにより、マイクロレンズ10や補助凸レンズ11を、曲率等について固体撮像装置の仕様上からの制約を受けることなく、製造プロセス上最も高精度に形成可能な形状にすることができる。但しこれらの層がなくても本発明の、スミア低減という基本的な効果は変わらない。

【手続補正21】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0080

【補正方法】変更

【補正内容】

【0080】実施例3の変形例. 図9は、上記第3実施例の変形例による固体撮像装置を示す断面図であり、図において、103aは本変形例の固体撮像装置で、その光束分散層130aは、光出射側光透過層39aと、上記光透過層39a上全面に、下地表面の凹凸形状がその表面形状に反映されるよう形成された光入射側光透過層39dとから構成されている。従ってここではレンズ層203は上記光入射側光透過層39dの表面の凸状部分から構成されており、また光出射側光透過層39aは、素子部201上に形成された、その表面が平坦な光透過層39alと、該膜39al上の、受光部3上に位置する部分に配設された補助凸レンズ11とから構成されている。

【手続補正22】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0081

【補正方法】変更

【補正内容】

【0081】ここで上記光透過層39a<u>1</u>及び補助凸レンズ11は屈折率が1.5程度のポリマーから構成されており、また光入射側光透過層39dは屈折率が1.9程度のシリコン窒化膜から構成されている。その他の点は上記第3実施例と同一である。なお図中、F3aは上記

補助凸レンズ11と<u>光入射側</u>光透過層39<u>d</u>との湾曲した接触界面であり、n39d は上記光透過層39dの屈折率を示している。

【手続補正23】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0082

【補正方法】変更

【補正内容】

【0082】次に製造方法について説明する。上記第3の実施例装置の製造方法で説明したように、上記素子部201を形成した後、<u>その表面が平坦な</u>光透過層39a」の形成(図10(a))及び補助凸レンズ11の形成(図10(b),(c))を順次行い、ECRプラズマCVDによりシリコン窒化膜を、下地表面の凹凸形状がその表面形状に反映されるよう上記熱リフロー温度以下で堆積して、光束分散層130a及びレンズ層203を形成する。これにより第3実施例の変形例に係る固体撮像装置103aを形成する(図10(d))。

【手続補正24】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0083

【補正方法】変更

【補正内容】

【0083】このような構成の第3実施例の変形例では、光東分散層130aを、屈折率の大きい光入射側光透過層39dと、屈折率の小さい平坦な光透過層39a 1及び補助レンズ11からなる光出射側光透過層39a とから構成し、上記両光透過層の接触界面の、上記受光部上の部分F3aを凸状に湾曲した凸レンズ形状としたので、レンズ層203により集光された入射光は、図12(c)を用いて説明したように、上記凸状に湾曲した接触界面F3aでの屈折により分散されることとなる。これにより受光部下側の基板部分での入射光の広がりを抑えて、スミアの発生を低減することができる効果がある。

【手続補正25】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0086

【補正方法】変更

【補正内容】

【0086】図において、104は本実施例の固体撮像装置で、ここでは光束分散層として、素子部201上に貼り付けられた凹レンズアレイ膜140を用い、レンズ層として、該凹レンズアレイ膜上に貼り付けられた凸レンズアレイ膜150を用いている。

【手続補正26】

【補正対象魯類名】明細書

【補正対象項目名】0091

【補正方法】変更

【補正内容】

[0091]

【発明の効果】以上のようにこの発明に係る固体撮像装置によれば、素子部とレンズ層との間に、屈折率の異なる2つの光透過層を有し、上記レンズ層により集光された集光光束をこれが平行光束により近い光束となるう上記光透過層での屈折により分散する光束分散層を配設したので、上記レンズ層により集光された入射光は、上記光束分散層の通過により集光角度がより小さい集光光束となって受光部に入射することとなり、これにより半導体基板の受光部下側部分での入射光の広がりが抑えられてCCDチャネル領域への光電荷の漏れ込みが少なくなり、スミアを低減することができる効果がある。

【手続補正27】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0098

【補正方法】変更

【補正内容】

【0098】この発明に係る固体撮像装置の製造方法によれば、複数の受光部及び電荷転送部を作り込んだ半導体基板上全面に第1の熱可塑性透明樹脂膜を下地表面の凹凸形状がその表面形状に反映されるよう堆積した後、該第1の透明樹脂膜をリフローしてその受光部上のの透明樹脂膜を形成することが部分を所定の凹状湾曲形状とし、その上に上記透明樹脂膜を形成することに対応したので、凹状に満足り、光東分散層を形成するようにしたので、凹状に満した屈折界面を各受光部に対応して有する光東分散層をサイドウォールやエッチングマスク層を用いることができる効果がある。

【手続補正28】

【補正対象暬類名】明細書

【補正対象項目名】 0099

【補正方法】変更

【補正内容】

【0099】この発明に係る固体撮像装置の製造方法によれば、複数の受光部及び電荷転送部を作り込んだ半導体基板上の平坦な第1の透明絶縁膜上に、熱可塑性透明樹脂のパターニング及び熱リフローを行って、上記複数の受光部に対応する各類にそれぞれ凸レンズを形成し、その後全面に上割りも低温でその表明な材料を上記熱リロで表別では大きいが平坦となるよう地縁膜を形成し、その後第2の透明絶縁膜を形成し、その後第2の透明絶縁膜を形成し、その後第2の透明絶縁膜を形成し、その後第2の透明絶縁膜を形成するようにしたので、北東分散層を形成するようにしたので、北東分散層を形成するようにしたので、北東分散層を形成するようにしたので、北東の大路関上の凸レンズはプロセス上最もでは、集光光東の集東角度や光路長の微調整により簡単に行うなができる効果がある。

【手続補正29】

【補正対象魯類名】明細書

【補正対象項目名】 0 1 0 0 【補正方法】変更

【補正内容】

【0100】この発明によれば上記固体撮像装置の製造方法において、第1の透明絶縁膜上の、上記複数の受光部に対応する各領域にそれぞれ補助凸レンズを形成した後、上記熱可塑性樹脂より屈折率が大きい透明材料を、下地表面の凹凸形状がその表面形状に反映されるよう、かつ熱リフロー温度よりも低温で堆積することにより、光束分散層及びレンズ層を形成するようにしたので、上

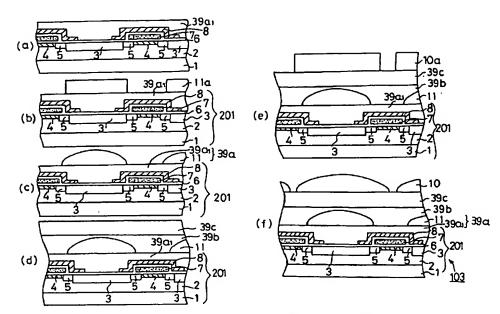
記補助凸レンズ上の平坦化膜の形成とレンズ層の形成とを1つの工程で行うことができ、製造プロセスを簡略化できる効果がある。

【手続補正30】 【補正対象曹類名】図面 【補正対象項目名】図7 【補正方法】変更 【補正内容】

[図7]

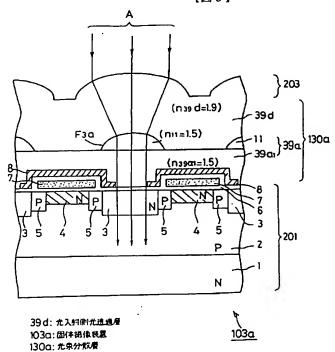
10 (n to=1.5) 39c F₹Þ (n39 C=1.5) (nn=1.5) 395 130 11 (nseb±1.9) 39a1}39a (n39cn=1.5) 201 Р Ν 103 11: 補助凸レンズ 103: 固体摄像数置 39点:尤出积极优级电阻 130: 北京分散層 39b:中間光透過層 39c: 尤入射例光线地图

【手続補正31】 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図8 【補正方法】変更 【補正内容】 【図8】



【手続補正32】 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図9

【補正方法】変更 【補正内容】 【図9】



【手続補正33】 【補正対象書類名】図面 【補正対象項目名】図10

【補正方法】変更 【補正内容】 【図10】

